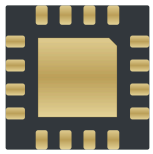
10000–18000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 45 dBm; PW = 200 µs; D = 30%

LCI-LIM-10000-18000-PIP45U · 10000–18000 MHz · GaAs 封装射频限幅器.

RF 电气表参数: 插入损耗 1.4 dB (典型值); 限幅电平 17 dBm (典型值); 输入耐受功率 45 dBm; PW = 200 µs; D = 30%. RF 测试条件: TA = +25 °C.



QFN16 3 × 3 mm

RF端口内置隔直电容。

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 2

RFout: 11

GND: 1, 3, 10, 12

NC: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16

封装外形尺寸: 3 × 3 × 0.75 mm.

RF 特性

TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作频率	f	10000	-	18000	-	MHz
插入损耗	IL	-	1.4	-	-	dB
限幅电平	PLim	-	17	-	-	dBm
输入耐受功率	Pp	-	-	-	45 (PW = 200 µs; D = 30%)	dBm

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最大脉冲输入功率 [1]	-	-	-	45	dBm
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	125	°C

[1] PW = 200 µs; D = 30%

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	3 × 3 × 0.75	mm

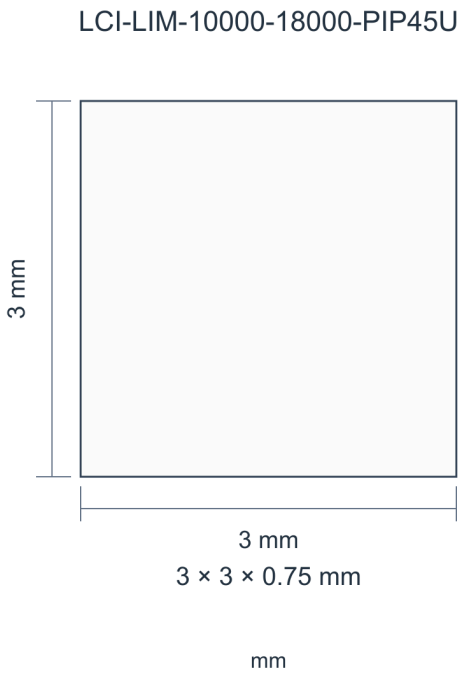
当前出版记录 · 1.3 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.2.

集成说明

QFN16 3 × 3 mm RF端口内置隔直电容。 T_peak ≤ 260 °C RFin: 2 RFout: 11 GND: 1, 3, 10, 12 NC: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16

机械外形尺寸图

安装尺寸参考图，单位为 mm。图中列出部分尺寸，安装时请参照完整安装图。



文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。